

2QP0225Txx-C 驱动器



该图片仅供参考，请以实物为准。

特征

- 双通道 IGBT 驱动器
- 功率器件最高电压 1700V
- 单通道驱动功率 2W，峰值电流 $\pm 25A$
- 适配 EconoDual 封装 1700V IGBT 模块
- 集成隔离 DC/DC 电源
- 20PIN 牛角接口输入 / 输出
- 兼容多种输入电平
- 集成原边 / 副边电源欠压保护
- 直接 / 半桥模式选择
- 集成有源钳位
- 集成 VCE 短路保护
- 集成软关断
- 集成过温保护

RoHS
COMPLIANT

[第 09 页](#)

[第 09 页](#)

[第 10 页](#)

[第 11 页](#)

[第 12 页](#)

[第 12 页](#)

主要参数

Vcc	15V
Vg	+15V, -10V
P, MAX	2W
Ig, MAX	$\pm 25A$
fs, MAX	200kHz
TA	-40°C ~85°C
绝缘耐压	5000V

描述

2QP0225Txx-C 是一款基于青铜剑自主开发的第二代 ASIC 芯片设计而成的 2 通道、紧凑型驱动器，针对中功率、中压、高可靠性领域设计而成。

2QP0225Txx-C 驱动器适用于 1700V 及以下电压的 EconoDual 封装 IGBT 模块搭建的两电平拓扑，即插即用的功能使驱动板可直接焊接在 IGBT 模块上使用，无需转接处理。

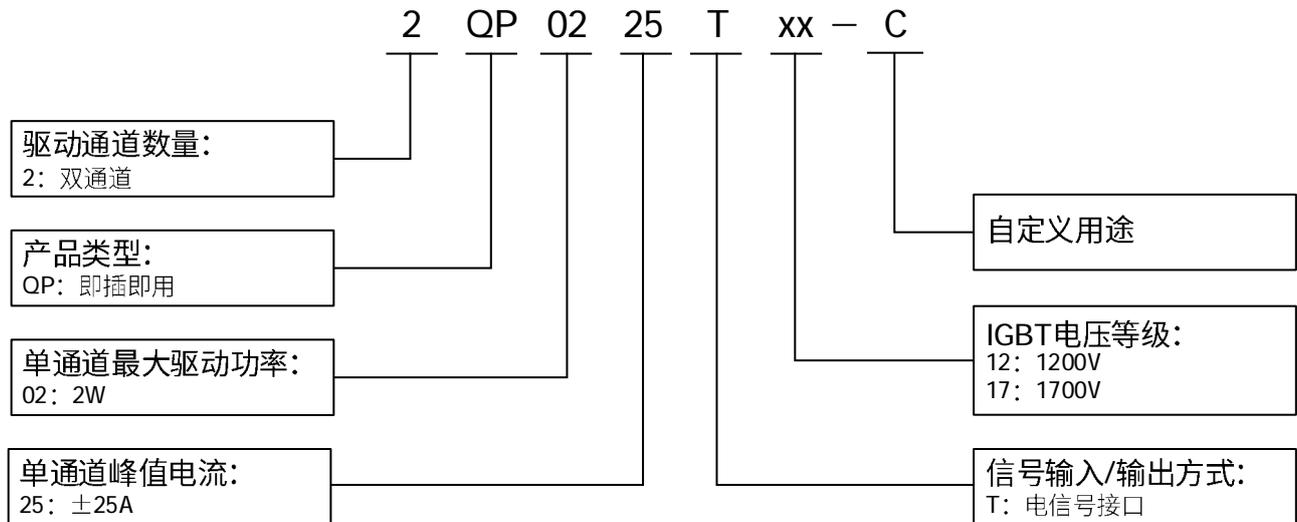
典型应用

- 风电变流器
- 光伏逆变器
- 储能变流器

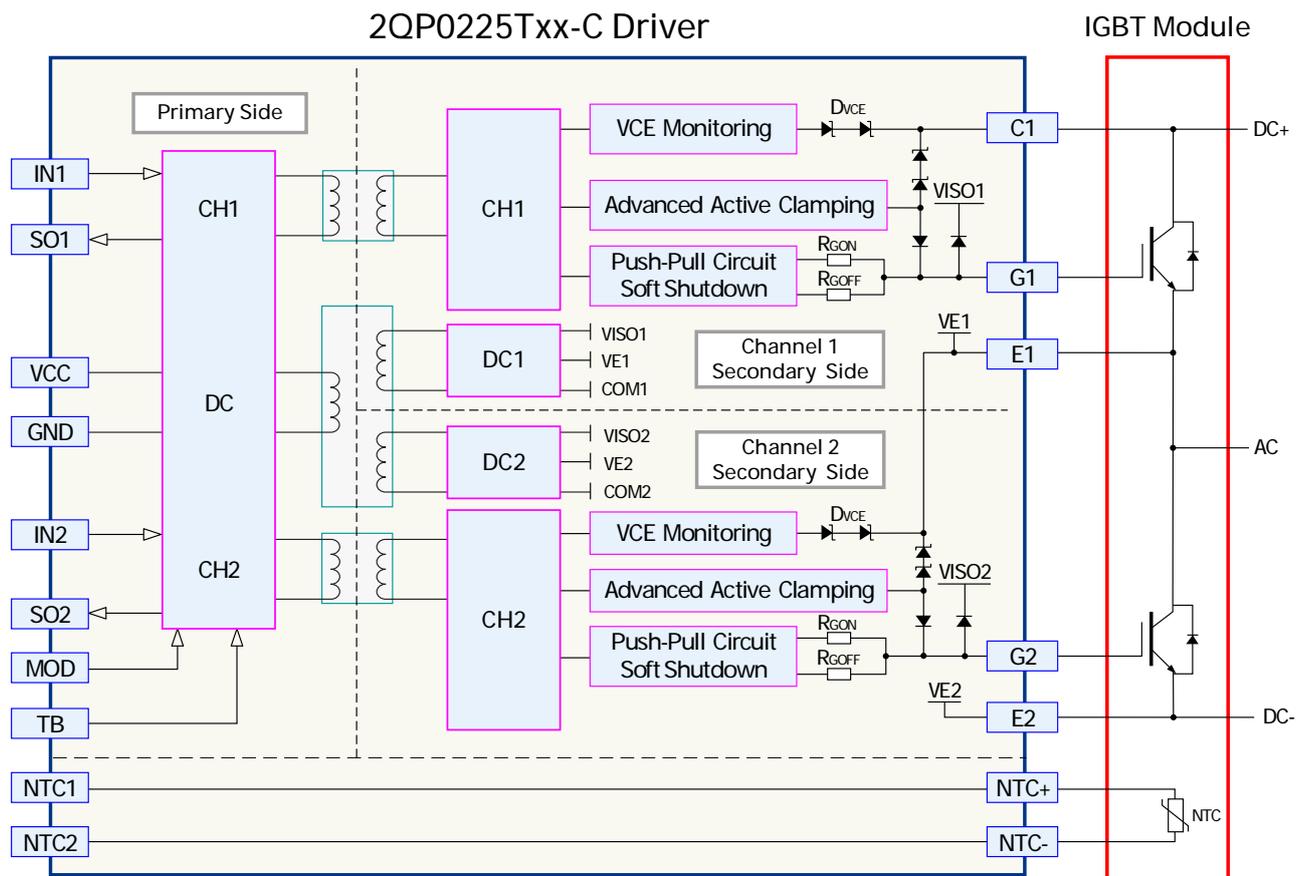
机械尺寸

机械尺寸图：参见 [第 13 页](#)

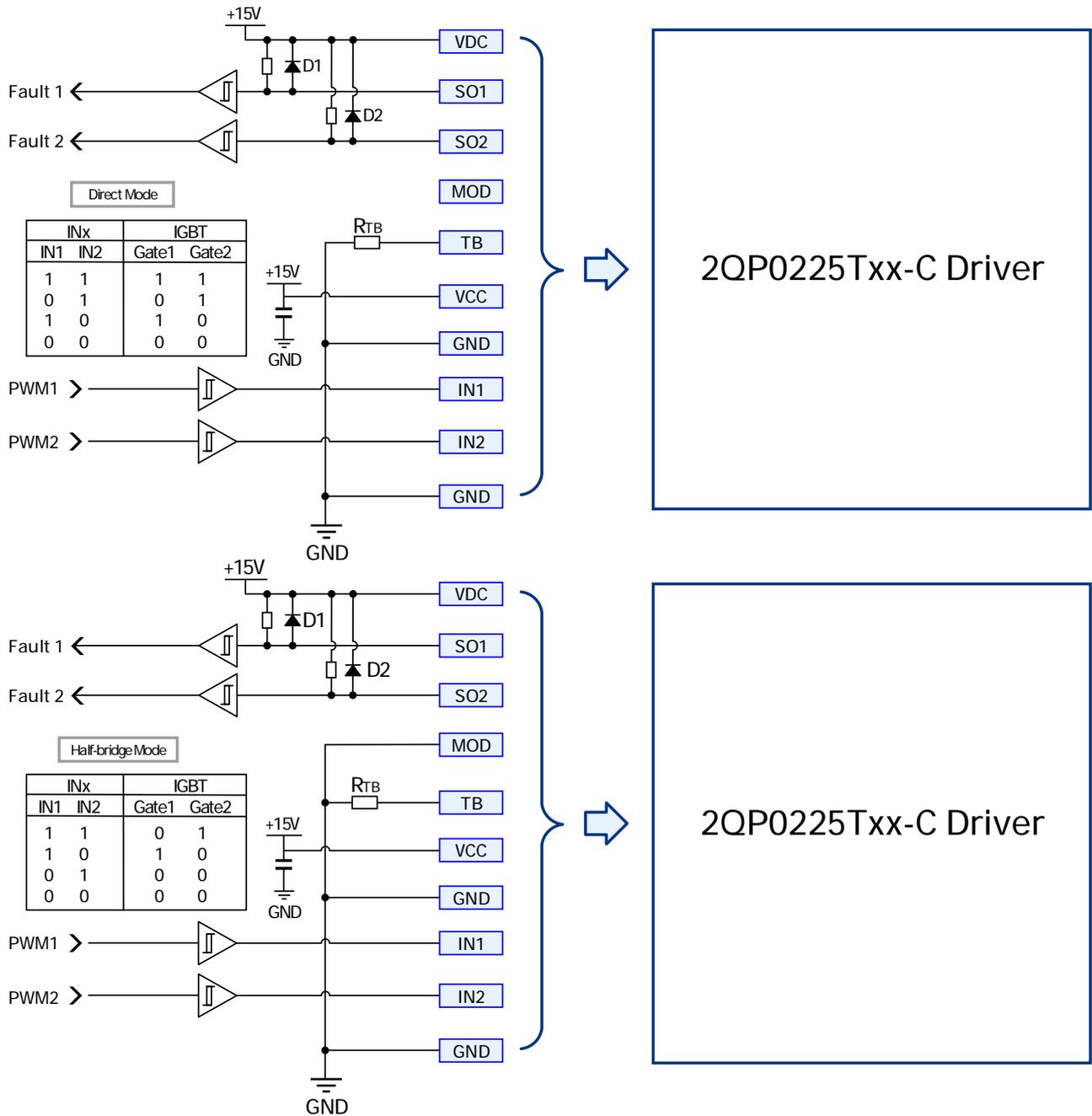
型号定义



原理框图



典型接线图



接口定义

P1 端子接口定义

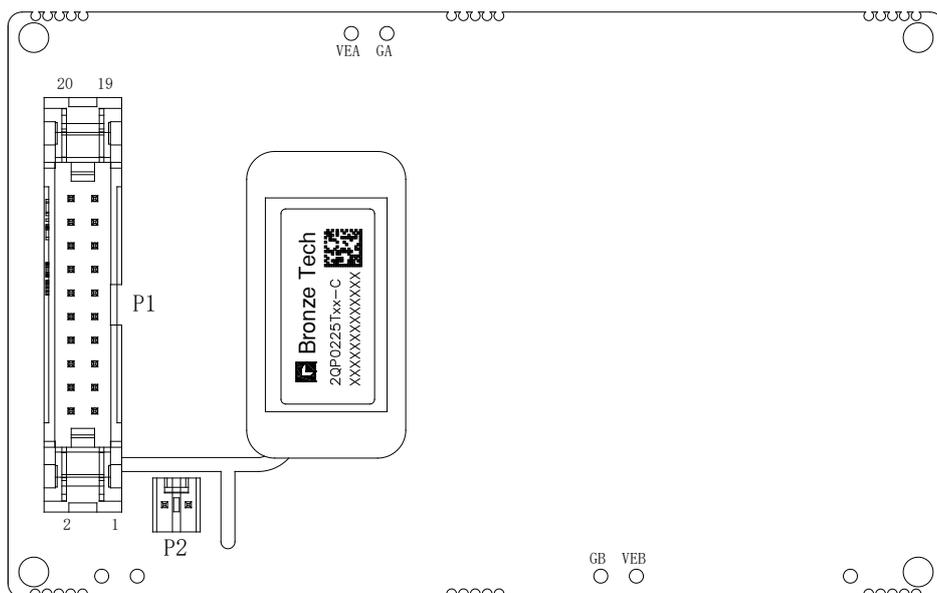
管脚	符号	说明	管脚	符号	说明
1	N.C	悬空	11	IN1	PWM 信号输入，对应通道 1（上管）
2	GND	信号 / 功率地	12	GND	信号 / 功率地
3	N.C	悬空	13	SO2	2 通道（下管）故障信号输出
4	GND	信号 / 功率地	14	GND	信号 / 功率地
5	VCC	供电电源输入 +	15	IN2	PWM 信号输入，对应通道 2（下管）
6	GND	信号 / 功率地	16	GND	信号 / 功率地
7	VCC	供电电源输入 +	17	MOD	模式选择，直接模式或半桥模式
8	GND	信号 / 功率地	18	GND	信号 / 功率地
9	SO1	1 通道（上管）故障状态输出	19	TB	保护闭锁时间设置
10	GND	信号 / 功率地	20	GND	信号 / 功率地

注：1) 默认配置接口 20 pin 牛角接头，型号为：230-010-820-209，品牌：正凌。

P2 端子接口定义

管脚	符号	说明
1	NTC1	模块 NTC 电阻 1 脚
2	NTC2	模块 NTC 电阻 2 脚

注：1) 型号为：22-27-2021_Molex。



2QP0225Tx-C 接口示意图

参数

绝对限值

参数		MIN	MAX	UNIT
VCC to GND			16	V
IN1, IN2, SO1, SO2 to GND			VCC+0.5	V
端口最高承受电压			250	V
门极驱动功率 ¹⁾			2	W
门极驱动电流			25	A
母线电压 ²⁾	2QP0225T12-C		800	V
	2QP0225T17-C		1200	V
供电电源最大电流 ³⁾			400	mA
最大开关频率 ⁴⁾			200	kHz
输入信号宽度		500		ns
原 / 副边绝缘电压			5000	V
副 / 副边绝缘电压			3000	V
运行温度 T _A		-40	85	°C
存储温度 T _S		-40	85	°C
湿度 ⁵⁾		5	95	%
海拔高度 ⁶⁾			3000	m
<p>注：1) 在 T_A 允许温度范围内，单通道最大输出功率。</p> <p>2) 默认有源钳位参数下允许的最大母线电压。</p> <p>3) 驱动板额定工况的最大值。</p> <p>4) 开关频率的参考需计算功率值，满足驱动器单通道 2W 以内的功率要求。</p> <p>5) 不允许出现凝露现象。</p> <p>6) 超过最大海拔高度应用请咨询深圳青铜剑技术公司。</p>				

供电电源

环境温度 $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $C_{GE}=10\text{nF}$, 除非另有说明。

参数	测试条件	MIN	TYP	MAX	UNIT
供电电压 V_{CC}	VCC to GND	14.5	15	15.5	V
转换效率	$V_{CC}=15\text{V}$		80		%
静态电流 I_{CCQ}	$V_{CC}=15\text{V}$, 空载	39	43	47	mA
供电电流	$V_{CC}=15\text{V}$, 空载, $f_{sw}=5\text{kHz}$	53	59	65	mA
	$V_{CC}=15\text{V}$, 空载, $f_{sw}=15\text{kHz}$, 50% 占空比	65	72	79	mA
	$V_{CC}=15\text{V}$, 200nF 负载, $f_{sw}=15\text{kHz}$, 50% 占空比	320	355	390	mA
副边全压 $V_{CCO}^{1)}$	VISO to COM	23	25	27	V
副边正压 V^+	VISO to VE	14	15	16	V
副边负压 $V^{-2)}$	COM to VE	-11	-10	-9	V
注: 1) 副边全压典型值为空载测试值。					
2) 副边负压典型值为空载测试值。					

输入

环境温度 $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $C_{GE}=10\text{nF}$, 除非另有说明。

参数	测试条件	MIN	TYP	MAX	UNIT
IN1, IN2 输入电压 $V_{IN}^{1)}$	电压限值	0		15.5	V
	开通阈值 V_{INH}	9.3			V
	关断阈值 V_{INL}			5.7	V
t_B 保护延时电阻 $^{1)}$	外部电阻 R_{TB}	150			k Ω
注: 1) 输入端需考虑电阻分压, 详见功能描述“触发信号 IN_x 输入”。					
2) 驱动器模式选择及死区时间配置电阻, 详见功能描述“传输逻辑和模式选择”。					
3) 驱动器保护锁定时间配置电阻, 详见功能描述“保护锁定时间 t_B 的设置”					

输出

环境温度 $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $C_{GE}=10\text{nF}$, 除非另有说明。

参数		测试条件	MIN	TYP	MAX	UNIT
门极输出电压 V_G	开通 ON-State	$V_{CC}=15\text{V}$, 空载	14.5	15	15.5	V
	关断 OFF-State	$V_{CC}=15\text{V}$, 空载	-11	-10.5	-10	V
门极峰值电流 $I_{G\text{ peak}}$	开通 ON-State	$V_{CC}=15\text{V}$			25	A
	关断 OFF-State	$V_{CC}=15\text{V}$	-25			A
SO 输出电压 $V_{SO}^{1)}$	正常状态	$V_{CC}=15\text{V}$, $R_{SO}=10\text{k}\Omega$	14.5	15	15.5	V
	保护状态 $^{2)}$	$V_{CC}=15\text{V}$, $R_{SO}=10\text{k}\Omega$	0.5		0.9	V
SO 端电流 I_{SO}		$V_{CC}=15\text{V}$, $R_{SO}=10\text{k}\Omega$	0		1.5	mA
NTC 电阻			由 IGBT 模块决定			
注: 1) R_{SO} 为保护输出端 SO 上拉电阻, 默认为 15V 上拉, 可根据客户需求调整。						
2) NTC 只是由端子 P2 引出, 未作任何电路处理。						

保护

环境温度 $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $C_{GE}=10\text{nF}$, 除非另有说明。

参数		测试条件	MIN	TYP	MAX	UNIT
原边欠压保护 阈值电压 $^{1)}$	触发 V_{CCUV+}	$V_{CC}=15\text{V}$, $V_{CC}-\text{GND}$		13.3		V
	恢复 V_{CCUVR+}	$V_{CC}=15\text{V}$, $V_{CC}-\text{GND}$		14.1		V
副边正压欠压 保护阈值电压 $^{1)}$	触发 V_{UV+}	$V_{CC}=15\text{V}$, $V_{ISO}-\text{VE}$		12		V
	恢复 V_{UVR+}	$V_{CC}=15\text{V}$, $V_{ISO}-\text{VE}$		12.4		V
副边负压欠压 保护阈值电压 $^{1)}$	触发 V_{UV-}	$V_{CC}=15\text{V}$, $\text{VE}-\text{COM}$		4.4		V
	恢复 V_{UDVR-}	$V_{CC}=15\text{V}$, $\text{VE}-\text{COM}$		5		V
短路保护阈值电压 V_{REF}		$V_{CC}=15\text{V}$		10.2		V
短路保护响应时间 $t_{SC}^{2)}$		$U_{BUS}>100\text{V}$, $R_A=10\text{k}\Omega$, $C_A=330\text{pF}$		7.9		us
软关断时间 t_{SOFT}		V_{gon} connecting to 0V, 200nF 负载		1.8		us
短路保护电流 I_{REF}		$V_{CC}=15\text{V}$		2.5		mA
保护锁定时间 t_B		R_{TB} 悬空, 驱动内部有 150k Ω 电阻		95		ms
短路保护传输延时时间 $t_{SO}^{3)}$		$V_{CC}=15\text{V}$, 副边短路保护动作到输出故障		530		ns
注: 1) 欠压保护时序图参见图 6。						
2) 采用二极管检测方式, 处于一类短路的情况。						
3) 副边保护动作开始 (8Pin 信号电平拉低) 到原边 SO 翻转的传输延迟时间。						

保护

环境温度 $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $C_{GE}=10\text{nF}$, 除非另有说明。

参数		测试条件	MIN	TYP	MAX	UNIT
传输延时 ¹⁾	开通延时 t_{ON}	$V_{CC}=15\text{V}$, $R_{MOD}=0\Omega$, $R_{GON}=R_{GOFF}=5\Omega$, $C_{GE}=10\text{nF}$, $f_s=15\text{kHz}$, 200nF 负载, $R_{11}=R_{12}=390\Omega$, $C_2=C_3=2.2\text{nF}$, 输入信号高电平幅值为 15V		850		ns
	关断延时 t_{OFF}			1050		ns
开关延时抖动 t_{JITTER}		输入信号上升沿 10% 到门极信号上升沿 10%		20		ns
输出信号上升时间 t_r		$R_{GON}=5\Omega$, $C_{GE}=10\text{nF}$, 200nF 负载		2400		ns
输出信号下降时间 t_f		$R_{GOFF}=5\Omega$, $C_{GE}=10\text{nF}$, 200nF 负载		2500		ns
死区时间 DT ²⁾		半桥模式, MOD 端接地		3.0		us
注: 1) 开通传输延时为输入信号上升沿 10% 到门极信号上升沿 10%, 关断传输延时为输入信号下降沿 90% 到门极信号下降沿 90%。 2) 客户端可使用直接模式, 并在控制端进行死区时间设置。						

安全和抗干扰

环境温度 $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $C_{GE}=10\text{nF}$, 除非另有说明。

参数		数值	UNIT
绝缘耐压 ¹⁾		5000	V
原边 - 副边 ²⁾	隔离等效电容	28	pF
	电气间隙	12	mm
	爬电距离	13.2	mm
副边 - 副边	隔离等效电容	68	pF
	电气间隙	8.8	mm
	爬电距离	8.8	mm
ESD 静电防护 ³⁾	接触放电	± 4	kV
	空气放电	± 8	kV
电快速瞬变脉冲群抗扰度		± 4	kV
脉冲磁场抗扰度		2	kV
注: 1) 测试条件为 5000V, 50Hz 交流电压, 1min。 2) 电气间隙和爬电距离, 按照 IEC 60077-1 标准设计。 3) EMC 测试安装 GB/T 17626 规范执行。			

功能描述

电源及电源监控

驱动器配有 DC/DC 电源，可实现电源和门极驱动电路的电气隔离。基本原理框图【见图 1】。

驱动器的原边及两个通道的副边都分别配备有电源监控电路，并实施欠压保护。

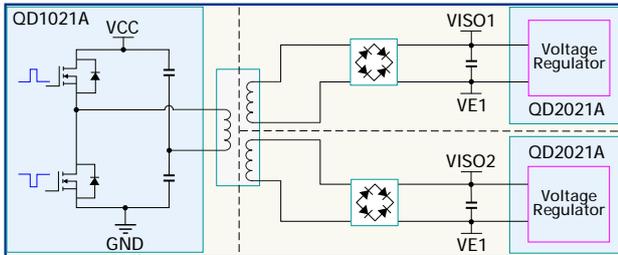


图 1 电源原理框图

原边电源监控：

原边对电源电压 V_{CC} 进行监控并实施欠压保护动作。当 V_{CC} 逐渐降低至欠压保护触发电压 V_{CCUV} 时，将触发欠压保护。两个副边驱动电路将锁定在关断状态，使 IGBT 保持在关断；同时输出保护信号 $SO1$ 和 $SO2$ 【见图 2】。

当 V_{CC} 恢复到欠压恢复值 V_{CCUVR} ，驱动器将继续保持保护状态一个锁定时间 t_B ，再释放驱动电路关断锁定状态，并恢复保护信号 $SO1$ 和 $SO2$ 。

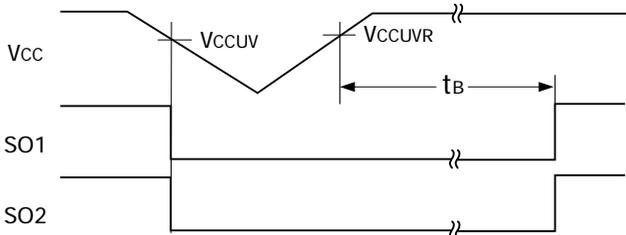


图 2 原边欠压保护逻辑图

副边电源监控：

副边电压在供电电压降低或负载超载情况下，会发生电压下降。当副边电压全压 V_{CCO} ($VISO$ 至 COM 下同) 下降时，驱动器会优先稳住正压 $V+$ ($VISO$ 至 VE 下同) 为 +15V，负压 $V-$ (COM 至 VE 下同) 逐渐抬升。当 $V-$ 抬升到 -5V 后，开始稳住负压，正压 $V+$ 开始跟随全压 V_{CCO} ($VISO$ 至 COM ，下同) 下降。当 $V+$ 下降至欠压保护阈值 V_{UV+} ，将启动副边欠压保护。

副边欠压保护首先会将本通道驱动锁定在关断状态，确保对应 IGBT 关断。同时向原边发送信号，使得原边输出对应通道的保护信号 SOx 。此时，另一通道不会受影响，仍能正常开关，其对应的 SO 信号为正常状态。

当故障情况解除， V_{CCO} 恢复后，驱动器会先恢复正压，再恢复负压。保护闭锁状态和 SO 信号将会等待一个闭锁时间 t_B ，再恢复正常。

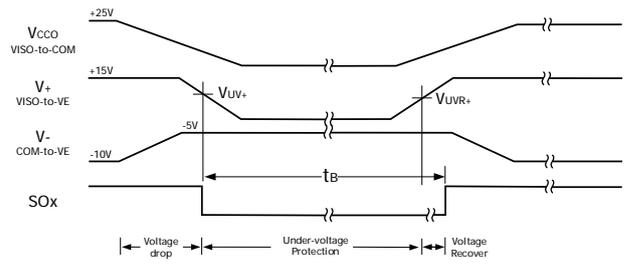


图 3 副边欠压保护逻辑图

触发信号 INx 输入

触发信号由 INx 端口输入，默认状态 $R13/R14=4.7k\Omega$, $R6/R9=1k\Omega$, $R11/R12$ 未焊接, $C2/C3$ 未焊接。

需改变输入信号电平时，可通过焊接不同的 $R11$ 和 $R12$ 电阻来改变输入信号开通门檻 V_{INH} 、关断门檻 V_{INL} 。

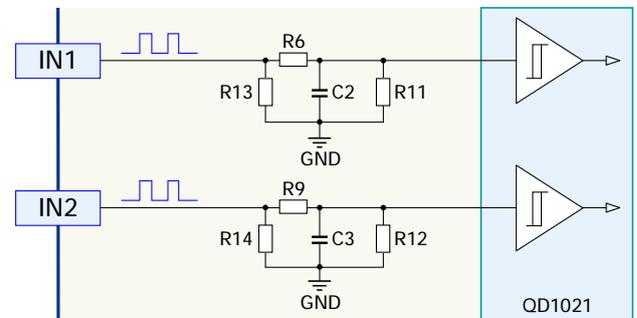


图 4 INx 输入电路图

传输逻辑和模式选择

驱动器可工作在直接模式或者半桥模式。可通过调整 MOD 端子的不同连接方式，选择驱动器的工作模式。

直接模式：

如果 MOD 端子未连接（悬空）或连接到 V_{CC} ，则选择了直接模式，传输逻辑【见图 5】。

直接模式时，两个通道各自独立，没有联系。输入 $IN1$ 对应 1 通道，而输入 $IN2$ 对应 2 通道；高电平将对应的 IGBT 开通，低电平将对应的 IGBT 关断。

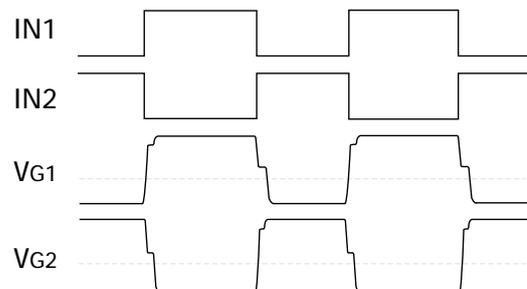


图 5 直接模式传输逻辑图

注意：此时触发信号间的死区时间由前端控制系统产生，请确保死区时间合适以避免发生上下管直通短路。

半桥模式：

如果 MOD 输入端子处在低电平（接地），驱动器就选择了半桥模式，传输逻辑【见图 6】。在这种模式下，IN1 为使能信号，而 IN2 为驱动信号输入。

当 IN1 为低电平时，两个通道都锁定在关断状态；如果 IN1 为高电平，则两个通道都被使能，且两个通道的门极输出由 IN2 来决定。当 IN2 信号由低变高，1 通道的门极信号会马上关断，经过一个死区时间 DT 后，2 通道的门极会开通；当 IN2 信号由高变低时，则是 2 通道门极信号马上关断，经过死区时间 DT 后 1 通道再开通。

死区时间 DT 为 3.2us。

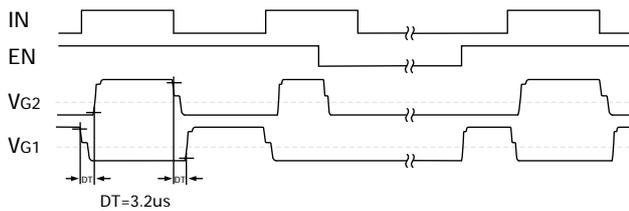


图 6 半桥模式传输逻辑图

保护锁定时间的设置

驱动器出现保护时，在启动保护并输出 SO 信号后都会闭锁一个 t_B 保护锁定时间。此 t_B 可通过在 TB 管脚和 GND 之间接一个外加电阻 R_{TB} 进行设置【见图 7】。

需要注意的是 2QP0225Tx-C 驱动器内部已经在 TB 端到 GND 设置了一个 150kΩ 电阻。 t_B 和 R_B 的关系由以下公式给出（典型值）：

$$t_B[\text{ms}] = \frac{150 \cdot R_{TB}[\text{k}\Omega]}{150 + R_{TB}[\text{k}\Omega]} - 55$$

$$(R_{TB} \geq 150\text{k}\Omega, 20\text{ms} \leq t_B \leq 130\text{ms})$$

当 R_{TB} 为 150kΩ 时，保护锁定时间 t_B 约为 20ms。

TB 管脚可以悬空，TB 管脚悬空时，保护锁定时间 t_B 约为 95ms。

注意， R_{TB} 电阻不能小于 150kΩ，即保护锁定时间 t_B 不能小于 20ms。如 R_{TB} 小于 150kΩ，保护锁定时间 t_B 将出现不准确和不稳定。但 TB 管脚可以接地，此时保护锁定时间 t_B 固定为 10us。

推荐将 TB 管脚悬空，此时保护锁定时间 t_B 约为 95ms。

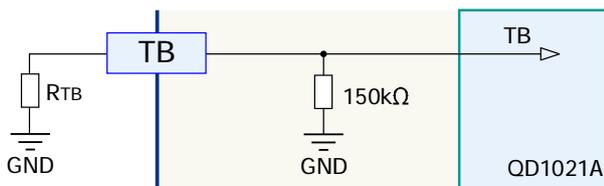


图 7 TB 管脚连接图

保护信号输出

保护信号输出端 SOx 内部为漏极开路形式【见图 8】。正常情况下， Q_{SO} 截止，SOx 输出端为高电平。当驱动器的某个通道出现保护时，对应通道的 Q_{SO} 将导通，SOx 变为低电平（接地）。默认状态 $R_2/R_3=10\text{k}\Omega$ ， $R_7/R_5=33\Omega$ 。

SO1 和 SO2 可连接在一起，以表达整个驱动的保护信息，但分开表达可实现快速且准确的诊断。

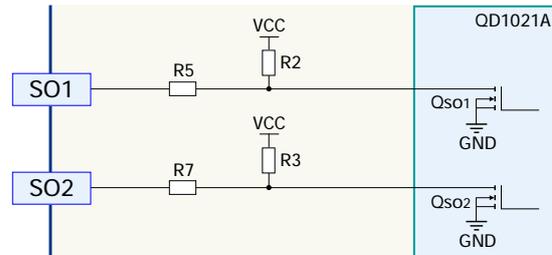


图 8 保护信号输出逻辑图

IGBT 的开通和关断

Q_{ON} 管打开， Q_{OFF} 管关闭，通过开通门极电阻 R_{GON} 对 IGBT 的门极进行充电，使 IGBT 开通。

当需要关断 IGBT 时，驱动器内部芯片内的 Q_{OFF} 管打开， Q_{ON} 管关闭，通过关断门极电阻 R_{GOFF} 对 IGBT 的门极进行放电，使 IGBT 关断。

门极电阻 R_{GON} 和 R_{GOFF} 的选择，用户可咨询我们技术支持来进行设置，并进行出厂预配置。在安装到对应的 IGBT 模块上时，请确保已经安装上合适的门极电阻。

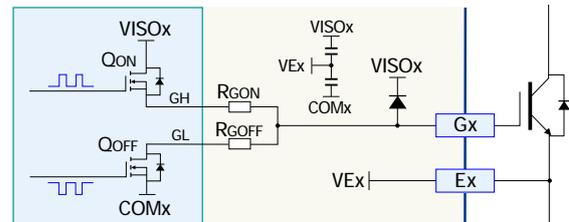


图 9 门极驱动电路图

高级有源钳位

快速的关断 IGBT 可能导致电压尖峰，电压尖峰会随母线电压和负载电流升高而增加，过高的电压尖峰会对 IGBT 的安全造成威胁。关断电压尖峰主要与系统杂散电抗 L_s 和 IGBT 关断电流变化率 di/dt 有关，通过调整关断门极电阻 R_{GOFF} 可适当减少 di/dt ，从而适当减少尖峰电压；但 L_s 的影响不可避免，特别是在短路和过流等大电流工况下，情况尤其恶劣。故此，驱动器配备了有源钳位电路，以抑制过电压尖峰，可以有效防止 IGBT 的过压损坏。

有源钳位电路的原理【见图 10】。在 IGBT 的集电极和门极之间用瞬态抑制二极管 (TVS) 建立一个反馈通道, 同时连接内部芯片的控制电路。

当 IGBT 的 V_{CE} 尖峰电压超过一个击穿阈值时, TVS 串将打通, 芯片内部控制电路启动使得关断驱动管 Q_{OFF} 关断; 同时 TVS 串流过的电流将会注入 IGBT 门极, 使得 IGBT 仍保持部分导通, 从而令 IGBT 的 V_{CE} 得到抑制。

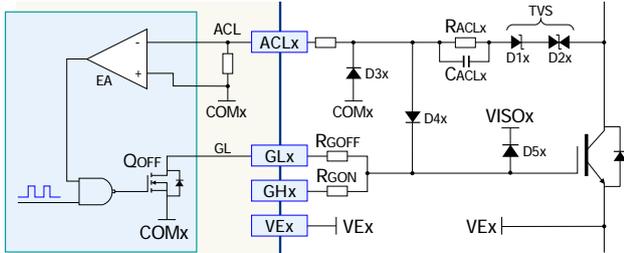


图 10 有源钳位电路原理框图

IGBT 短路保护

驱动器的 IGBT 短路保护使用 V_{CE} 检测电路【见图 11】，两个通道各自独立。短路保护功能只在 IGBT 开通的时候有效；在 IGBT 关断状态，触发信号会将 Q_{CE} 打开，使得 V_{CEDT} 钳位在 $COMx$ (相对 V_{Ex} 为 $-10V$ 左右)，比较器不动作。

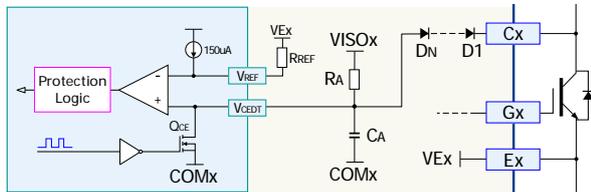


图 11 短路保护检测原理框图

正常开通时的表现:

当驱动器执行 IGBT 开通动作时, 传输到副边的触发信号会将 Q_{CE} 关断, 释放 V_{CEDT} 钳位状态。此时 IGBT 的 V_{CE} 仍处于高水平, 将通过 R_A 电阻对 C_A 电容进行充电, 使得 V_{CEDT} 电平逐渐抬升。随后 IGBT 开通, V_{CE} 迅速下降至 V_{CE-SAT} , V_{CEDT} 也随之通过二极管放电至 V_{CE-SAT} 【见图 12】。由于 V_{CE-SAT} 远低于保护触发值 V_{REF} , 比较器不动作, 保护不启动。

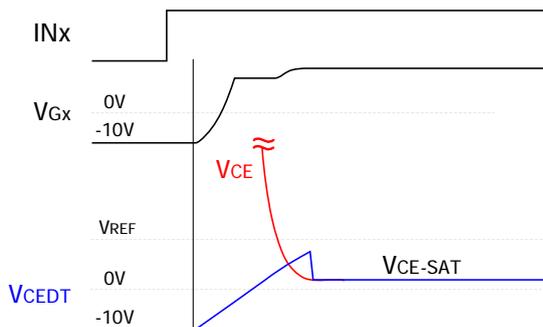


图 12 正常开通时 V_{CEDT} 信号波形图

一类短路保护:

当 IGBT 发生一类短路 (即直通) 时, 由于直通电流增长很快, IGBT 将迅速退饱和, V_{CE} 很快回到高位。因此 C_A 将会一直充电, 使得 V_{CEDT} 一直增长直到钳位至 V_{ISOx} (相对 V_{Ex} 为 $+15V$)。在此过程中, V_{CEDT} 会越过 V_{REF} , 使得比较器翻转, 从而启动短路保护逻辑。

短路保护逻辑会先把 IGBT 迅速关断, 保障 IGBT 的安全。同时向原边发出信息, 使得 SOx 管脚拉低, 以表达出保护状态。保护状态将会锁定一个 t_B 时间, 然后自动恢复到正常状态。

两个通道的保护电路是相互独立的, 所以在一个通道发生短路保护的情况下, 另一通道仍然能够工作在正常状态。控制系统需要及时检测 SO 信号, 并根据策略发出系统闭锁命令【见图 13】。

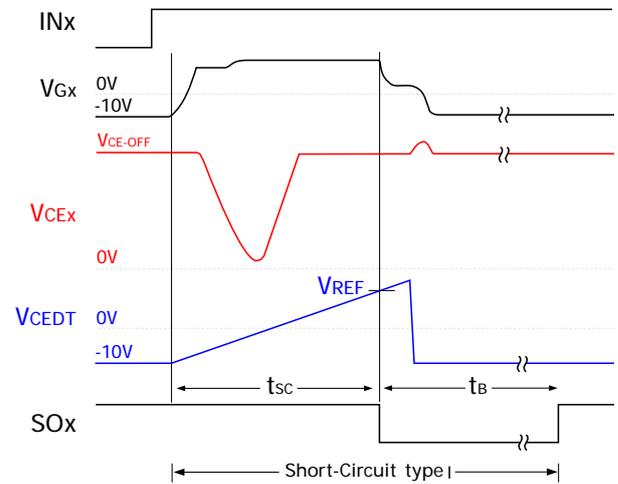


图 13 一类短路保护逻辑图

二类短路保护:

当 IGBT 发生二类短路 (相间短路) 时, 由于短路回路阻抗较大, 电流增长较缓慢。IGBT 仍能正常进入饱和状态, 然后随着短路电流的增加, V_{CE} 逐渐增加直至退饱和【见图 14】。驱动器只有在 IGBT 退饱和时才能检测出短路状态, 启动短路保护。因此, 二类短路保护的响应时间会比一类短路保护响应时间要更长。

当 IGBT 在低母线电压下发生直通短路时, 由于母线电压低导致直通电流较小, IGBT 也会呈现与二类短路保护相同的特征, 相应的保护响应时间也会加长。

注意: 二类短路时, 由于短路回路阻抗随机性较大, 使得 IGBT 退饱和时刻不确定性较大。因此在 IGBT 保护动作前, 有可能已产生较大的热量损耗而导致 IGBT 损坏。即, 此种状态下驱动器短路保护并不能保证 IGBT 不损坏, 系统需辅以过流保护等其他手段, 以保障 IGBT 的安全。

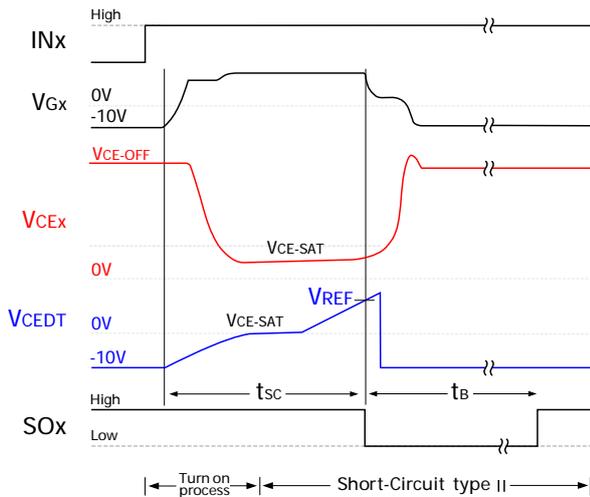


图 14 二类短路保护逻辑图

软关断功能

由于连接 IGBT 模块的母线存在杂散电感，在 IGBT 短路保护关断时会产生较大的尖峰电压，为抑制该尖峰电压，并不影响正常关断速度，就需要加入软关断功能。

副边芯片 QD2021A 内置软关断功能，当出现故障时，通过对门极电压的控制，实现 IGBT 软关断，保护 IGBT。主要实现方式如下：

1、芯片内部一旦检测到故障信号（短路故障或者欠压故障），芯片迅速关闭开通 MOS，同时保持关断 MOS 关闭状态，此时 IGBT 门极电压不变；

2、芯片内部 V_{REF} 按照固定的斜率下降，而 IGBT 门极电压没有变，GH 与 V_{REF} 就存在差值，比较放大模块对输入的 GH 和 V_{REF} 电压差值进行比较放大，产生一个控制电压；

3、控制模块对输入的控制电压做出响应，产生关断电压，使得门极电压缓慢下降，GH 也随着门极电压下降，当 GH 下降得较大时，GH 比 V_{REF} 小，控制模块就会关闭关断 MOS，控制门极电压的下降，不断的重复这个过程；

4、最终门极电压始终保持和内部 V_{REF} 电压同样的趋势下降，达到软关断的目的。下降时间为 2.1us，门极电压降到 0V 时，门极直接硬关【见图 15】。

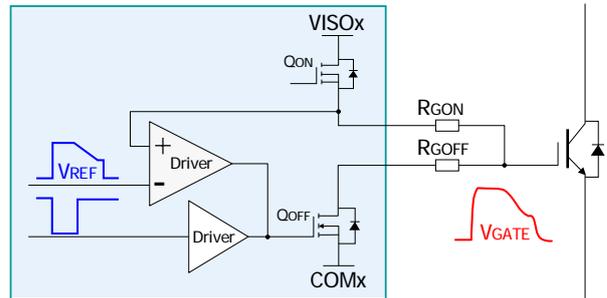
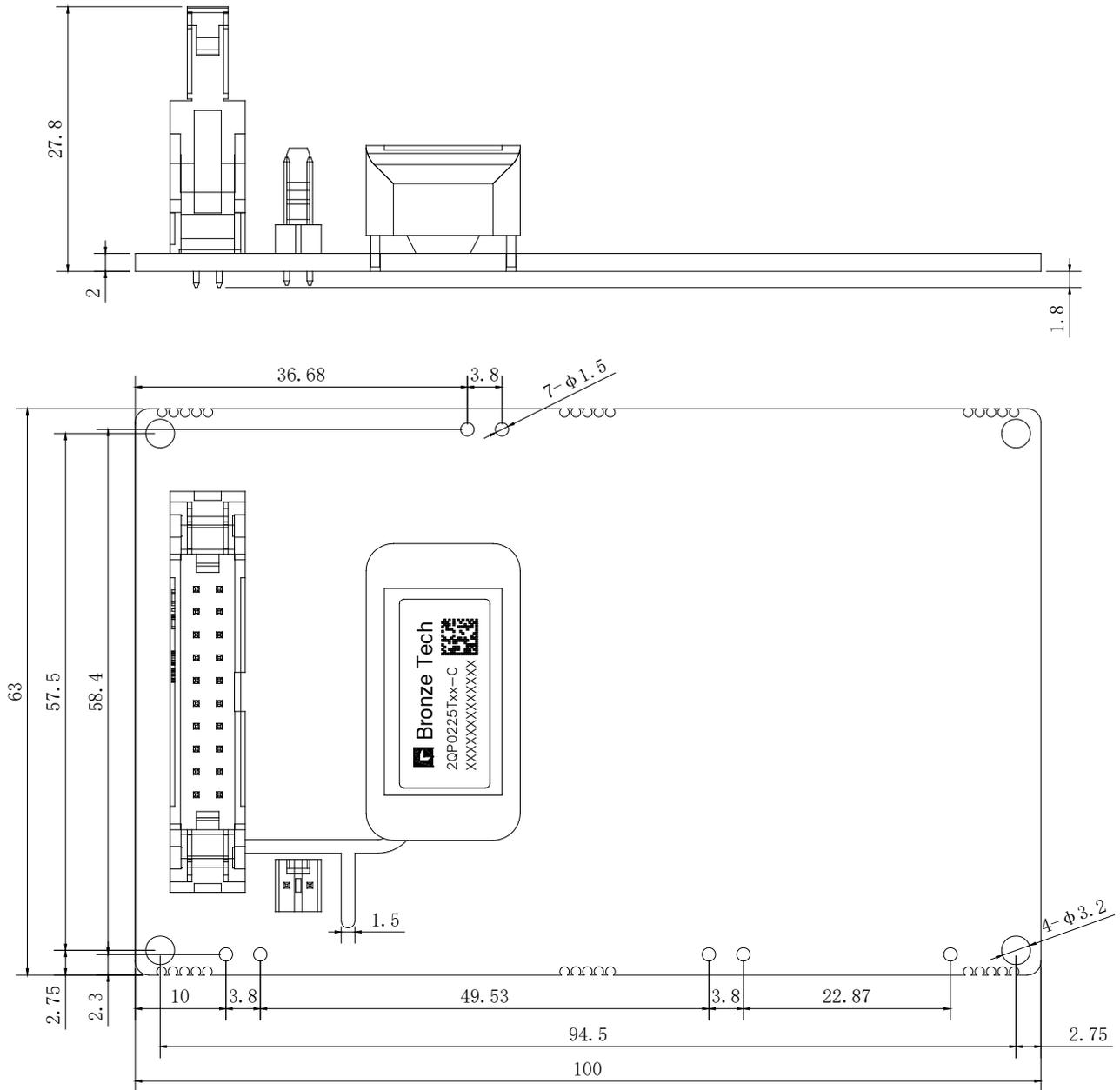


图 15 软关断示意图

温度采样和保护

驱动器将模块 NTC 引脚直接接出，不做任何处理。

机械结构图



- 注 1) 图示单位为 mm;
- 2) 图中公差符合 ISO 2768-1。

版本说明

版本号	变更内容	修订日期
V1.0	新发布	07-Apr-2022
V1.1	内容优化	17-Jun-2022
V1.2	参数调整	25-Apr-2023

注意事项

- IGBT 模块和驱动器的任何操作，均需符合静电敏感设备保护的通用要求，请参考国际标准 IEC 60747-1/IX 或欧洲标准 EN100015。为保护静电感应设备，要按照规范处理 IGBT 模块和驱动器（工作场所、工具等都必须符合这些标准）。



如果忽略了静电保护要求，IGBT 模块和驱动器可能都会损坏！

- 驱动器上电前，请确认驱动器和控制板连接可靠，无空接、虚接、虚焊现象。
- 驱动器安装后，其表面对大地电压可能会超过安全电压，请勿徒手接触！



使用中，可能危及生命，务必遵守相关的安全规程！

免责声明

青铜剑技术提供的技术和可靠性数据（包括数据手册等）、设计资源（包括 3D 模型、结构图、AD 模型）、应用指南、应用程序或其他设计建议、工具、安全信息和资源等，不包含所有明示和暗示的保证，包括对交付、功能、特定用途、适用性保证和不侵犯第三方知识产权的保证。

这些资源旨在为使用青铜剑技术产品进行开发的熟练工程师提供。为您全权负责：

- 为您的产品选择适当的青铜剑技术产品；
- 设计、验证和测试您的产品；
- 确保您的产品符合适用的要求。

青铜剑技术保留随时修改数据、文本和资料的权力，恕不另行通知。

请随时访问青铜剑技术网站 www.qtjtec.com 或微信公众号，以获取最新的资料。

青铜剑技术授权您仅在应用青铜剑技术产品的开发过程，使用相应的资源，禁止以其他方式复制和展示这些资源。青铜剑技术没有通过这些资源，授予任何青铜剑技术的知识产权或第三方知识产权许可。

对于因您使用这些资源而引起的任何索赔、损害、损失和成本，青铜剑科技不承担任何责任，并且有权追偿因侵犯知识产权而造成的损失。

